

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
10. Juni 2010 (10.06.2010)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2010/063587 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

B01J 19/24 (2006.01) **C01B 33/025** (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2009/065466

(22) Internationales Anmeldedatum:

19. November 2009 (19.11.2009)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

10 2008 059 769.4

1. Dezember 2008 (01.12.2008)

DE

61/118,821

1. Dezember 2008 (01.12.2008)

US

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **EVONIK DEGUSSA GMBH** [DE/DE]; Relinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **LANG, Jürgen, Erwin** [DE/DE]; Niddastr.28b, 76229 Karlsruhe (DE). **RAULEDER, Hartwig** [DE/DE]; Uhlandweg 51A, 79618 Rheinfelden (DE). **FRINGS, Bodo** [DE/DE]; Grauthoffweg 106 b, 33758 Schloss Holte (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

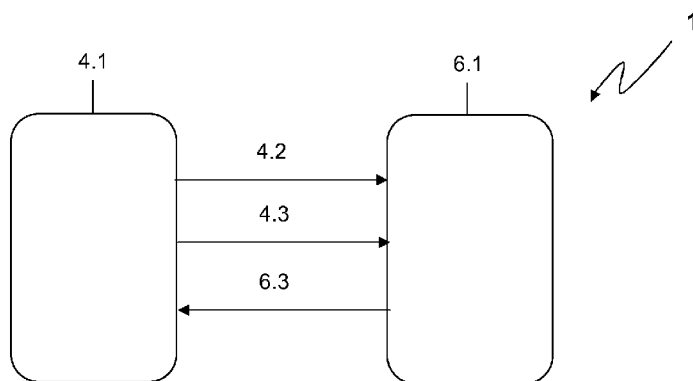
(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

(54) Title: SYSTEM FOR PRODUCING SILICON WITH IMPROVED RESOURCE UTILIZATION

(54) Bezeichnung : ANLAGE ZUR HERSTELLUNG VON SILIZIUM MIT VERBESSERTER RESSOURCENNUTZUNG



Figur 1

(57) Abstract: The present invention relates to a system for producing silicon, preferably high-purity silicon, particularly solar silicon, and to a method for producing silicon, preferably high-purity silicon, in particular solar silicon, in each case with particularly effective resource utilization and reduced emission of pollutants.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anlage zur Herstellung von Silizium, vorzugsweise hochreinem Silizium, insbesondere Solarsilizium, sowie ein Verfahren zur Herstellung von Silizium, vorzugsweise hochreinem Silizium insbesondere Solarsilizium, jeweils mit besonders effektiver Ressourcenausnutzung und verringerter Emission von Schadstoffen.

WO 2010/063587 A1